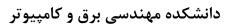


دانشگاه تهران

دانشکدگان فنی



آزمایشگاه مدارهای مخابراتی



تمرین کامپیوتری اول

درس مدارهای مخابراتی

استاد درس:

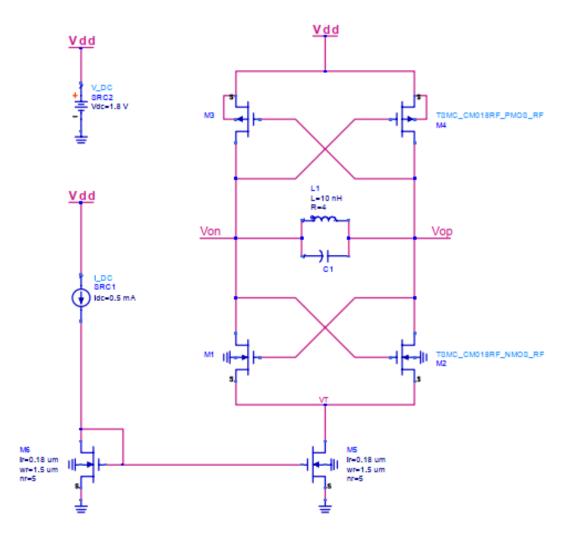
دکتر محمود کمرهای

تاریخ بارگذاری: ۱۹ فروردین

موعد تحویل: ۱۵ اردیبهشت

بهار ۱۴۰۲

1GHz با ساختار نشان داده شده در شکل زیر در فرکانس $Complementary\ Differential\ VCO$ بهدف این پروژه طراحی یک $0.18\mu m\ CMOS\ RF$ انجام دهید.



- f_{osc} = 1 GHz
- $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$
- $C_{\text{ox}} \approx 8.5 \, f\text{F}/\mu\text{m}^2$
- $\mu_{\rm n} C_{\rm ox} \approx 200 \ \mu \text{A/V}^2$
- $\mu_p C_{ox} \approx 67 \, \mu \text{A/V}^2$

۱- برای فرکانس نوسان GHz مقدار C1 را محاسبه نمایید. سپس R_P (مقاومت معادل موازی دیده شده از دو سر تانک) را محاسبه کنید.

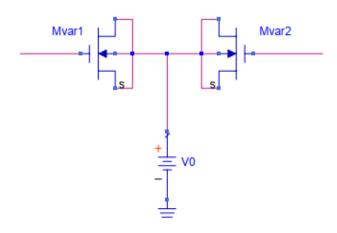
 M_{1} - با توجه به م شخ صات داده شده برای ترانزی ستورها، اندازه ترانزی ستورهای M_{1} - با توجه به م شخ صات داده شده برای ترانزی ستورها، اندازه RP/2- شود. در اینصورت شرط نوسان ($ROut \mid < RP \mid$) به خوبی دیده شده در خروجی بدون در نظر گرفتن مدار تانک برابر $ROut \mid < RP \mid$ شامین خواهد شسید. به منظور حفظ تقارن اندازه RMOS ها را $Rout \mid < ROS$ ها در نظر بگیرید.

۳- با استفاده از شبیه سازی تحلیل S-PARAMETERS بدون در نظر گرفتن مدار تانک، مقاومت خروجی مدار را بدست آورید و با قسمت ۲ مقایسه کنید.

 9 - با قرار دادن تانک در مدار، با استفاده از شبیه سازی تحلیل Transient شکل موج ولتاژ خروجی مثبت و منفی (Vop و تا toons (toons رسم نمایید. همچنین در 2 پریود پایانی (در بازه حدود toons تا toons (toons) شکل موجهای ولتاژ خروجی تفاضلی (toonsin t) جریان تانک را نیز رسم نمایید. سپس فرکانس نوسان مدار را گزارش نمایید. (اندازه گیری از روی پریود در نمودار) راهنمایی: برای راه اندازی اسیلاتور در شبیه سازی toonsin t باید یک جریان ضربههای کوتاه (با استفاده از toonsin t مثلا به مدت toonsin t و دامنه toonsin t) به یکی از گرههای خروجی مدار وارد کرد تا مدار از حالت تعادل خارج گردد. در دنیای واقعی نویز این کار را انجام می دهد.

 $^{-0}$ حال می خواهیم این اسیلاتور را به یک $^{-0}$ تبدیل کنیم. بدین منظور، بجای خازن $^{-0}$ از دو ترانزیستور به شکل زیر به عنوان $^{-0}$ معنوان $^{-0}$ استفاده نمایید (مشخصه خازن گیت وابسته به ولتاژ میباشد). اندازه ترانزیستورهای $^{-0}$ استفاده نمایید که مقدار خازن کل برابر $^{-0}$ در حالت قبل شود. با توجه به بزرگ بودن ابعاد این ترانزیستورها، از ترانزیستورهای معمولی (غیر $^{-0}$) به عنوان $^{-0}$ استفاده کنید.

vdd/2 باشد. vdd/2 ولتاث



 9 با استفاده از شبیه سازی $^{1.2V}$ از 0V استفاده از قسمت 0V استفاده از قسمت 0V می توان 0V را تغییر داد. برای رسم نمودار نیز 0V باید رسم شود.

در خلاصه گزارش باید به ترتیب خواستههای پروژه در قسمتهای ۱ تا ۶ پاسخ داده شوند.

data در درون پوشه پروژه قرار داده شود و پوشه PDF در درون پوشه پروژه قرار داده شود و پوشه ZIP در خروجی شبیه سازی که حجیم میباشند) در آن پاک شود. سپس کل این پوشه به یکی از فرمتهای ZIP یا (شامل دادههای خروجی شبیه سازی که حجیم میباشند) در آن پاک شود. سپس کل این پوشه به یکی از فرمتهای RAR و به نام خودتان فشرده شود و در سایت ایلرن بارگذاری کنید. طبیعتاً به پروژه بدون گزارش نمرهای تعلق نخواهد گرفت.

هشدار: در صورت هرگونه تقلب، به هیچکدام از طرفین نمرهای تعلق نخواهد گرفت.

برای پرسیدن سوال در رابطه با تکلیف می توانید علاوه بر بنده در شبکههای اجتماعی، در روزهای سه شنبه به ازمایشگاه مدارهای مخابراتی مراجعه کنید و از مهندس ملکی، مهندس قدیری، خانم مهندس محبتی و خانم مهندس بهجتی سوالهای مرتبط با شبیه سازی عناصر را بپرسید. دقت کنید که صورت پروژه را به همراه خود داشته باشید.

موفق و موید باشید

کزازی